

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成30年11月1日(2018.11.1)

【公開番号】特開2017-223815(P2017-223815A)

【公開日】平成29年12月21日(2017.12.21)

【年通号数】公開・登録公報2017-049

【出願番号】特願2016-118475(P2016-118475)

【国際特許分類】

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

【F I】

G 0 9 F 9/30 3 3 8

H 0 1 L 29/78 6 1 6 S

H 0 1 L 29/78 6 1 6 V

H 0 1 L 29/78 6 1 6 T

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 1 9 A

H 0 1 L 29/78 6 1 6 L

【手続補正書】

【提出日】平成30年8月28日(2018.8.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 8】

一方、上部電極 17b は、例えばその端部 e1 が、酸化物半導体層 15 の一部に重なるように成形される。このとき、上部電極 17b は、その端部 e1 が絶縁膜 16b の端部 e2 よりも張り出して形成される（端部 e2 が端部 e1 よりも後退した位置に形成される）ように加工される。また、加工条件により、端部 e1 のエッジ形状（側面の形状）および幅等を調整することで、上述のように、低抵抗領域 15b のオーバーラップ領域 15b1 の幅 D を制御することも可能である。尚、図 9 等の図面では、上部電極 17b の端部 e1 のエッジ（側面）は、基板面に対して垂直な面としているが、傾斜面であってもよい。